



# XG58030KS

30W, 1-6GHz, 28V GaN 射频功率晶体管



Jun 15 2025

Product datasheet.V1.0

## 概要描述

XG58030KS 是一款 30W 的 28V GaN 射频功率晶体管，采用独特的匹配拓扑结构，可实现 1GHz 至 6GHz 频率的超宽带应用。它可以支持 CW、脉冲或其他调制信号应用。

当其应用于其他频率时，无法保证其性能。

## 典型应用性能

测试条件： V<sub>ds</sub>=28V, V<sub>gs</sub>=-2.18V, I<sub>dq</sub>=50mA

测试 1000-6000MHz 的典型性能，焊接装配，信号模式： CW

Freq (MHz)	P1dB (dBm)	P1dB (W)	P1dB Eff(%)	P1dB Gain(dB)	P3dB (dBm)	P3dB (W)	P3dB Eff(%)
1000	43.5	22.4	47.2	14.15	44.81	30.3	55.1
1500	45.11	32.4	49.9	13.65	46.47	44.4	55.5
2000	45.96	39.5	58.9	14.27	47.26	53.2	66.4
2500	44.92	31.1	64.1	14.53	46.24	42.1	71.0
3000	43.52	22.5	54.9	11.89	45.23	33.4	62.6
3500	44.98	31.5	49.3	10.61	46.14	41.1	52.7
4000	44.69	29.4	44.7	12.4	45.76	37.6	48.0
4500	44.01	25.2	39.5	11.6	45.21	33.2	43.1
5000	44.34	27.2	39.2	12.18	45.53	35.7	42.6
5500	44.92	31.0	42.4	13.01	46.2	41.7	46.1
6000	43.4	21.9	43.6	13.56	45.23	33.4	50.5

XG58030KS

Product datasheet

2025-06-15

东科芯微电子(南京)有限公司

## 产品特点

- 适用于无线通信基础设施，宽带放大器、EMC 测试、ISM 等；
- 提供出色的效率和线性化能力；
- 耐热增强型工业标准封装；
- 符合有害物质限制（RoHS）指令 2002/95/EC 无铅。
- 采用高可靠性金属化工艺；
- 优异的热稳定性以及坚固性；

## 加电顺序

### 打开设备

- 将  $V_{GS}$  加至 -5V
- 将  $V_{DS}$  打开至额定工作电压(28V)
- 增加  $V_{GS}$ ，直到出现  $I_{DS}$ ，表明晶体管开启
- 打开驱动，输入功率

### 关闭设备

- 先关闭驱动
- 将  $V_{DS}$  降低至 -5V，过程中  $I_{DS}$  逐渐降低至 0 mA
- 将  $V_{DS}$  降低至 0 V
- 关闭  $V_{GS}$

## 典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻 (管芯封装至法兰) 测试条件: $T_C = 85^\circ\text{C}$ , $T_J = 200^\circ\text{C}$ , FAE	$R_{\theta JC}$	2.6	°C/W

表 2. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏极电压	$V_{DSS}$	150	Vdc
栅极电压	$V_{GS}$	-10,+2	Vdc
工作电压	$V_{DD}$	36	Vdc
最大正向栅极电流	$I_{gmx}$	8	mA

参数	符号	值	单位
储存温度范围	T <sub>stg</sub>	-65 to +150	°C
封装工作温度	T <sub>c</sub>	+150	°C
工作结温	T <sub>j</sub>	+225	°C

注意：1、在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

2、偏置条件还应满足以下表达式：Pdiss < (T<sub>j</sub>-T<sub>c</sub>)/R<sub>JC</sub>、T<sub>c</sub> = T<sub>case</sub>。

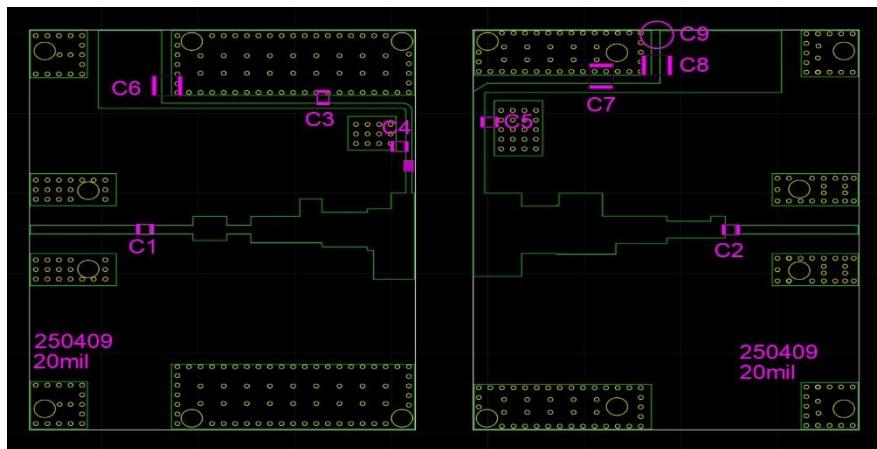
表 3.电学特性参数(TC=25°, 除非特殊注明)

直流特性					
参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>(BR)DSS</sub> --击穿电压	V <sub>GS</sub> =-8V、I <sub>DS</sub> =8mA	150			V
V <sub>GS(th)</sub> --开启电压	V <sub>DS</sub> =28V、I <sub>D</sub> =8mA		-2.5		V
V <sub>GS(Q)</sub> --栅极静态电压	V <sub>DS</sub> =28V、I <sub>DS</sub> =50mA		-2.2		V

注意：V<sub>GS(Q)</sub>--栅极静态电压：数据来源于典型应用测试。

## 典型测试曲线与版图

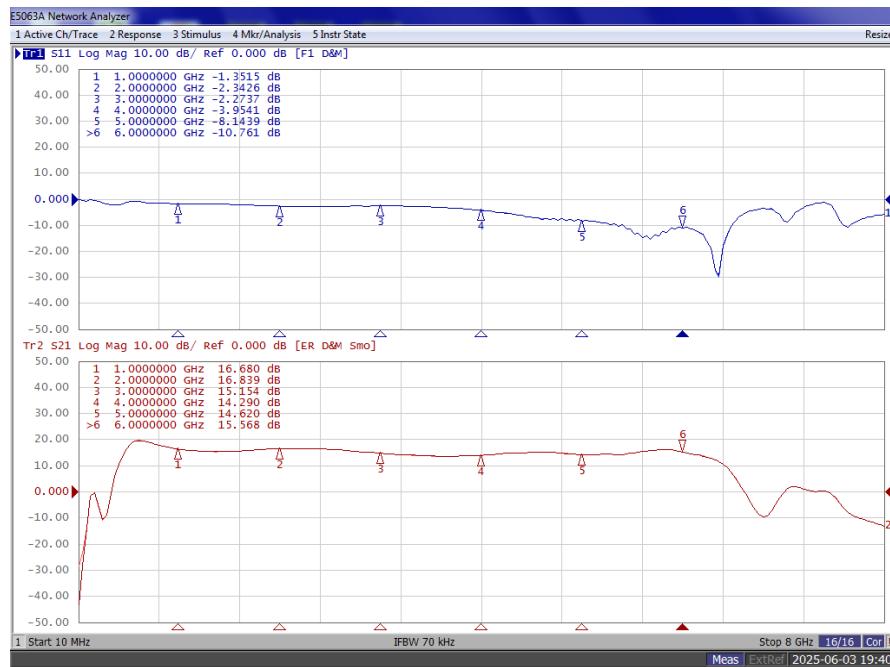
### 测试版图



测试频段 1-6GHz(20 Mil Rogers 4350)

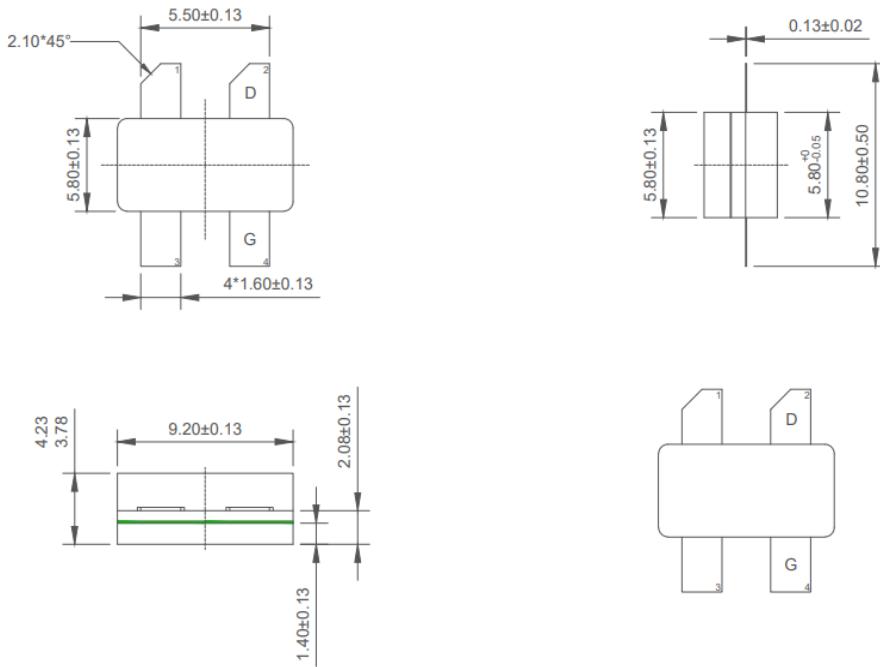
30W, 1-6GHz, 28V GaN 射频功率晶体管

## 小信号测试性能曲线



更多测试数据具体见测试报告。

## 封装尺寸图



注意：所有尺寸均以毫米（mm）为单位。

## 版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2025-06-15	1.0	发布初版数据手册	

### 注意事项

- (1) 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.rfwatt.com/>.
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。更多频段测试数据请参考相应测试报告。